

18 NOV. 2004



REC'D 07 FEB 2005

WIPO

PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 29 SEP. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

BEST AVAILABLE COPY

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75300 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITE

26bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 Paris Cédex 08
Téléphone: 01 53.04.53.04 Télécopie: 01.42.94.86.54

Code de la propriété intellectuelle-livreVI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

DATE DE REMISE DES PIÈCES: N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL: DÉPARTEMENT DE DÉPÔT: DATE DE DÉPÔT:	Jean LEHU BREVATOME 3, rue du Docteur Lancereaux 75008 PARIS France
Vos références pour ce dossier: B14319 FG -YD184	

1 NATURE DE LA DEMANDE				
Demande de brevet				
2 TITRE DE L'INVENTION				
		MATERIAU HYBRIDE INORGANIQUE-ORGANIQUE SEMI-CONDUCTEUR P-N, SON PROCEDE DE FABRICATION ET CELLULE PHOTOVOLTAÏQUE COMPRENANT LEDIT MATERIAU		
3 DECLARATION DE PRIORITE OU REQUETE DU BENEFICE DE LA DATE DE DEPOT D'UNE DEMANDE ANTERIEURE FRANCAISE		Pays ou organisation	Date N°	
4-1 DEMANDEUR				
Nom Rue Code postal et ville Pays Nationalité Forme juridique		COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 31-33, rue de la Fédération 75752 PARIS 15ème France France Etablissement Public de Caractère Scientifique, Technique et Ind		
5A MANDATAIRE				
Nom Prénom Qualité Cabinet ou Société Rue Code postal et ville N° de téléphone N° de télécopie Courrier électronique		LEHU Jean Liste spéciale: 422-5 S/002, Pouvoir général: 7068 BREVATOME 3, rue du Docteur Lancereaux 75008 PARIS 01 53 83 94 00 01 45 63 83 33 brevets.patents@brevalex.com		
6 DOCUMENTS ET FICHIERS JOINTS		Fichier électronique	Pages	Détails
Texte du brevet		textebrevet.pdf	36	D 31, R 4, AB 1
Dessins		dessins.pdf	2	page 2, figures 3
Pouvoir général				

7 MODE DE PAIEMENT				
Mode de paiement		Prélèvement du compte courant		
Numéro du compte client		024		
8 RAPPORT DE RECHERCHE				
Etablissement immédiat				
9 REDEVANCES JOINTES				
	Devise	Taux	Quantité	Montant à payer
062 Dépôt	EURO	0.00	1.00	0.00
063 Rapport de recherche (R.R.)	EURO	320.00	1.00	320.00
Total à acquitter	EURO			320.00

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

Signé par

Signataire: FR, Brevatome, J.Lehu

Emetteur du certificat: DE, D-Trust GmbH, D-Trust for EPO 2.0

Fonction

Mandataire agréé (Mandataire 1)



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Réception électronique d'une soumission

Il est certifié par la présente qu'une demande de brevet (ou de certificat d'utilité) a été reçue par le biais du dépôt électronique sécurisé de l'INPI. Après réception, un numéro d'enregistrement et une date de réception ont été attribués automatiquement.

Demande de brevet : X
Demande de CU :

DATE DE RECEPTION	17 novembre 2003	
TYPE DE DEPOT	INPI (PARIS) - Dépôt électronique	Dépôt en ligne: X Dépôt sur support CD:
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUE PAR L'INPI	0350841	
Vos références pour ce dossier	B14319 FG -YD184	

DEMANDEUR

Nom ou dénomination sociale	COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
Nombre de demandeur(s)	1
Pays	FR

TITRE DE L'INVENTION

MATERIAU HYBRIDE INORGANIQUE-ORGANIQUE SEMI-CONDUCTEUR P-N, SON PROCEDE DE FABRICATION ET CELLULE PHOTOVOLTAÏQUE COMPRENANT LEDIT MATERIAU

DOCUMENTS ENVOYES

package-data.xml	Requetefr.PDF	fee-sheet.xml
Design.PDF	ValidLog.PDF	textebrevet.pdf
FR-office-specific-info.xml	application-body.xml	request.xml
dessins.pdf	indication-bio-deposit.xml	

EFFECTUE PAR

Effectué par:	J. Lehu
Date et heure de réception électronique:	17 novembre 2003 15:14:33
Empreinte officielle du dépôt	52:FD:47:EB:A3:5E:27:02:0D:B8:37:94:BC:B5:03:0C:AC:67:D5:CC

/ INPI PARIS, Section Dépôt /

SIEGE SOCIAL
INSTITUT 26 bis, rue de Saint-Petersbourg
NATIONAL DE 75800 PARIS cedex 03
LA PROPRIÉTÉ Téléphone : 01 53 04 53 04
INDUSTRIELLE Télécopie : 01 42 93 59 90

**MATERIAU HYBRIDE INORGANIQUE-ORGANIQUE SEMI-CONDUCTEUR
P-N, SON PROCEDE DE FABRICATION ET CELLULE
PHOTOVOLTAÏQUE COMPRENANT LEDIT MATERIAU**

5

DESCRIPTION

DOMAINE TECHNIQUE

La présente invention se rapporte à un matériau hybride inorganique-organique semi-conducteur P-N destiné à entrer dans la constitution d'une cellule photo-électrochimique, plus particulièrement d'une cellule photovoltaïque.

La présente invention a également trait à un procédé de fabrication d'un tel matériau et à une cellule photovoltaïque comprenant ledit matériau.

Le domaine général de l'invention est donc celui des cellules photo-électrochimiques, plus particulièrement les cellules photovoltaïques ou encore les diodes électroluminescentes.

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

Une cellule photovoltaïque est un dispositif permettant la conversion d'une énergie photochimique en énergie électrique.

Généralement, une cellule photovoltaïque se compose de matériaux semi-conducteurs dopés P (c'est-à-dire présentant un déficit d'électrons, c'est-à-dire des trous de charges) et de matériaux semi-conducteurs dopés N (c'est-à-dire présentant un excès d'électrons), réunis par une jonction dite « jonction P-N », qui permet une séparation entre les électrons et les trous de charge. Cette séparation génère une différence de

potentiel à la jonction P-N et par conséquent un courant électrique si l'on place un contact sur la zone N et un contact sur la zone P et une résistance (à savoir un dispositif destiné à être alimenté en courant électrique) entre ces deux contacts.

Ainsi, lorsque la lumière frappe la zone de la cellule constituée de la jonction entre le matériau semi-conducteur de type P et le matériau semi-conducteur de type N, les photons constitutifs de la lumière sont absorbés par ladite zone et chaque photon absorbé donne naissance à un électron et un trou (on parle de paire électron-trou), ladite paire étant séparée à la jonction du matériau de type N et du matériau du type P, créant ainsi une différence de potentiel de part et d'autre de cette jonction.

Jusqu'à récemment, la plupart des cellules photovoltaïques ont été fabriquées à partir de silicium, plus précisément de silicium dopé par des atomes tels que du phosphore pour constituer la zone N et de silicium dopé par des atomes tels que du bore pour constituer la zone P de la cellule. Toutefois, l'utilisation du silicium s'avère coûteuse.

Pour remédier à cet inconvénient, la recherche s'est attachée à développer de nouveaux matériaux pouvant entrer dans la constitution de cellules photovoltaïques.

Ainsi, des cellules photovoltaïques ont été conçues à partir d'un matériau semi-conducteur de type P-N comprenant une zone semi-conductrice N solide et une zone semi-conductrice P liquide. Plus précisément,

la zone semi-conductrice N est constituée d'une
céramique oxyde poreuse, par exemple du dioxyde de
titane dont les pores sont remplis d'un électrolyte
liquide conducteurs de charges, cet électrolyte
5 remplissant le rôle de zone semi-conductrice P.

Ce type de cellule photovoltaïque est
notamment décrit dans la demande internationale de
brevet WO 93/19479 [1].

Toutefois, il a été constaté que les
10 cellules photovoltaïques utilisant un électrolyte
liquide présentent les inconvénients suivants :

- une faible stabilité dans le temps, liée
à l'évaporation des solvants entrant dans la
composition de l'électrolyte ;
- 15 - une plage de température de
fonctionnement relativement limitée en raison du
caractère volatil des solvants entrant dans la
constitution de l'électrolyte ;
- un risque de précipitation des sels
20 entrant dans la constitution de l'électrolyte, lorsque
la cellule photovoltaïque est amenée à fonctionner à
des températures très basses, telles que des
températures de l'ordre de -10°C à -40°C .
- une mise en œuvre contraignante du fait
25 de l'utilisation d'un électrolyte liquide, excluant
notamment l'emploi de supports organiques souples et/ou
de grandes dimensions.

Pour remédier à cela, les travaux de
recherche se sont focalisés sur la conception de
30 cellules photovoltaïques comprenant des matériaux semi-
conducteurs P-N, comprenant à la fois une zone semi-

conductrice N solide et une zone semi-conductrice P solide.

Ainsi, la demande de brevet EP 1176646 [2] décrit des cellules photovoltaïques comprenant une zone
5 semi-conductrice N constituée d'une céramique oxyde de titane sensibilisée par des nanoparticules de semi-conducteur inorganique et comprenant une zone semi-conductrice P constituée par une molécule organique conducteur de trous appartenant à la famille des
10 composés spiro- et hétérospiro, en particulier le polymère 2,2',7,7'-tétrakis(N,N-di-p-méthoxyphénylamine)9,9'-spirobifluorène (connu sous l'abréviation OMeTAD). Cette zone P est obtenue par enduction centrifuge (ou « spin coating » selon la terminologie
15 anglo-saxonne) de la zone N avec une solution comprenant l'OMeTAD et du chlorobenzène. Toutefois, le temps de contact entre la solution contenant de l'OMeTAD et la couche en oxyde de titane est relativement court du fait de l'évaporation rapide du
20 chlorobenzène et de la méthode de dépôt utilisée. Ceci se traduit notamment par une interpénétration limitée des zones N et P, cette interpénétration limitée étant également due à la diffusion lente des molécules d'OMeTAD vers la surface interne de la céramique (à
25 savoir la surface de paroi des pores). Cette interpénétration limitée des zones N et P se traduit par un rendement solaire très faible.

De plus, l'interaction entre la zone N constituée d'une céramique oxyde et la zone P
30 constituée par le polymère conducteur de charges susmentionné est une interaction faible, du fait que le

polymère conducteur se lie à la céramique par le biais d'interactions faibles de type Van der Waals.

La demande de brevet EP 0 917 208 [3] décrit une cellule photovoltaïque comprenant un film photoactif constitué d'une matrice de polymère organique à base de polyparaphénylènevinylène (connu sous l'abréviation PPV) dans laquelle sont dispersées des nanoparticules de type semi-conducteur (en particulier TiO_2). Dans cette configuration, le PPV assure la fonction de conducteurs de trous (c'est-à-dire la fonction d'une zone semi-conductrice P) et la fonction d'une substance chromophore en absorbant les photons issus de la lumière tandis que les nanoparticules dispersées assurent le rôle de conducteur d'électrons (zone semi-conductrice N). Cependant, ce type de configuration présente les inconvénients suivants :

- la dispersion de nanoparticules dans la matrice organique limite la percolation de celles-ci et ainsi la conduction des électrons vers la couche collectrice d'électrons de la cellule photovoltaïque ;

- la dispersion de nanoparticules dans la matrice organique induit un fort taux de recombinaison électron-trou à l'interface PPV/nanoparticules.

La demande de brevet WO 93/20569 [4] décrit une cellule photovoltaïque à colorant, comprenant une zone constituée par un film poreux d'oxyde de titane sensibilisé par une substance chromophore et une zone constituée d'un polymère conducteur de trous. Le procédé de fabrication de ce type de cellule photovoltaïque consiste à déposer à haute température

(de l'ordre de 300°C) le polymère conducteur à l'état fondu sur le film poreux d'oxyde de titane. Toutefois, le matériau obtenu présente les inconvénients suivants:

5 - il se caractérise par une interpénétration entre le film poreux et le polymère limitée par la diffusion du polymère à l'état fondu dans la porosité du film d'oxyde de titane ;

10 - il comprend une jonction lâche entre le matériau semi-conducteur N et le matériau semi-conducteur P du fait que la liaison entre ces deux zones se fait par des interactions faibles de type Van der Waals ;

15 - l'opération réalisée à haute température (de l'ordre de 200 à 300°C) peut endommager la substance chromophore et empêcher l'utilisation d'une large gamme de substances chromophores aux températures de décomposition basses.

20 Ainsi, il ressort des réalisations de l'art antérieur l'un ou plusieurs des inconvénients suivants limitant les performances :

 - une interpénétration limitée de la zone semi-conductrice N et de la zone semi-conductrice P ;

25 - un fort taux de recombinaison électron-trou à la jonction de ces zones du fait de la faible interpénétration des différents composants zone N/chromophore/zone P.

30 Les inventeurs se sont donc fixé pour objectif de fournir un matériau semi-conducteur de type P-N qui soit exempt des inconvénients mentionnés ci-dessus, notamment en ce qu'il présente une interaction

forte entre la zone semi-conductrice P et la zone semi-conductrice N, et qui permet toutefois de limiter les phénomènes de court-circuit entre ces deux zones.

Ces buts sont atteints par la présente invention qui propose notamment un matériau hybride inorganique-organique semi-conducteur de type P-N.

EXPOSÉ DE L'INVENTION

Ainsi, l'invention a trait, selon un premier objet, à un matériau semi-conducteur P-N susceptible d'être obtenu par un procédé comprenant successivement les étapes suivantes :

- une étape de fonctionnalisation d'un substrat en céramique oxyde poreuse (sensibilisée ou non par une ou plusieurs substances chromophores) par greffage chimique d'un ou plusieurs composés comprenant au moins un groupe susceptible d'être polymérisé avec un ou plusieurs précurseurs d'un polymère conducteur de l'électricité et au moins un groupe apte à se greffer chimiquement audit substrat ;

- une étape d'imprégnation dudit substrat ainsi fonctionnalisé par une solution comprenant le ou lesdits précurseur(s) ;

- une étape de polymérisation du ou desdits précurseurs.

Avant d'entrer plus en détails dans la description, nous proposons les définitions suivantes.

Par matériau semi-conducteur, on entend selon l'invention un matériau semi-conducteur de type P-N, c'est-à-dire que ce matériau doit comprendre une zone semi-conductrice de type N et une zone semi-conductrice de type P. Dans le cadre de l'invention, la zone semi-conductrice de type N peut être constituée par le substrat susmentionné, auquel cas la zone

conductrice de type P sera constituée par le ou les polymères conducteurs de l'électricité résultant de l'étape de polymérisation. Inversement, la zone conductrice de type N peut être constituée par le ou les polymères conducteurs de l'électricité résultant de l'étape de polymérisation, auquel cas la zone semi-conductrice de type P est constituée par le substrat en céramique poreuse. On précise également que ce matériau peut se présenter sous forme d'un bloc (ou d'une pièce) ou encore sous forme d'un revêtement (par exemple d'un film présentant une épaisseur de 10 nm à 100 μ m).

Par polymère conducteur de l'électricité, on entend un polymère présentant des propriétés de conduction électrique sans dopage (auquel cas le polymère sera un polymère conducteur intrinsèque de l'électricité) ou avec dopage (auquel cas le polymère sera un polymère conducteur extrinsèque de l'électricité), la conduction électrique étant véhiculée soit par le biais d'électrons (en ce qui concerne les polymères conducteurs de type N), soit par le biais de trous, qui correspondent à des 'espaces' laissés vacants par des électrons (en ce qui concerne les polymères conducteurs de type P). Des exemples spécifiques de ces différents types de polymères seront donnés ultérieurement.

Par greffage chimique, on entend, dans ce qui précède et ce qui suit, une immobilisation du ou des composés sus-mentionnés sur le substrat susmentionné par le biais d'une liaison chimique covalente, voire iono-covalente. On précise que cette immobilisation se fait à la fois à la surface externe du substrat et également à la surface interne dudit substrat, c'est-à-dire sur la surface de parois des pores du substrat. Il est bien entendu que le greffage chimique n'exclut pas l'existence d'interactions

simples physiques telles que des interactions dites de Van der Waals ou des interactions de type de liaisons hydrogène entre les composés susmentionnés et le substrat susmentionné.

5 Par groupe apte à se greffer chimiquement audit substrat, on entend des groupes réagissant avec les groupes réactifs présents sur la céramique oxyde, tels que des groupes -OH, ces groupes -OH résultant d'un phénomène d'hydratation spontanée de la céramique, 10 soit sous l'effet de l'humidité de l'atmosphère ambiante, soit sous l'effet d'une humidité provoquée pour créer ces groupes.

Par précurseur de polymère conducteur de l'électricité, on entend des monomères, éventuellement 15 des oligomères (assemblage de 2 ou plusieurs dizaines d'entités monomères) dont la polymérisation conduit à des polymères conducteurs de l'électricité.

Ainsi, contrairement aux réalisations de l'art antérieur, le matériau semi-conducteur P-N 20 présente une jonction entre la zone semi-conductrice P et la zone semi-conductrice N résultant d'un greffage chimique.

De ce fait, les matériaux de l'invention présentent une jonction améliorée par rapport aux 25 matériaux de l'art antérieur entre la surface du substrat en céramique oxyde et le ou les polymères résultant de l'étape de polymérisation du ou desdits précurseurs mentionnés ci-dessus.

De plus, les matériaux de l'invention 30 présentent une amélioration de l'interpénétration des polymères dans la céramique. Ceci est due au fait que les matériaux de l'invention sont obtenus par un procédé mettant en œuvre une étape d'imprégnation d'un substrat en céramique oxyde poreuse avec des

précurseurs de polymère et non des polymères en soi, ce qui permet une amélioration de l'interpénétration dans la céramique poreuse des espèces s'infiltrant en raison de la taille des précurseurs inférieures à la taille des polymères utilisés dans l'art antérieur.

Ainsi, les matériaux de l'invention présentent à la fois une meilleure jonction entre la surface du substrat en céramique oxyde et le ou les polymères et une meilleure interpénétration de ceux-ci dans la céramique poreuse et donc une meilleure interpénétration des zones N et P susmentionnées.

Le ou les groupes aptes à se greffer chimiquement à la céramique peuvent être choisis parmi les groupes de formules suivantes :

- 15 - COOR^1 avec R^1 représentant un atome d'hydrogène, un groupe alkyle comprenant de 1 à 30 atomes de carbone ou un groupe phényle ;
- COCl ;
- $\text{COCH}_2\text{CO}-\text{R}^1$ avec R^1 représentant un atome d'hydrogène, un groupe alkyle comprenant de 1 à 30 atomes de carbone ou un groupe phényle ;
- 20 - $\text{PO}(\text{OH})_2$, $-\text{PO}(\text{OR}^2)(\text{OH})$ ou $-\text{PO}(\text{OR}^2)(\text{OR}^3)$ avec R^2 et R^3 , identiques ou différents, représentant un groupe alkyle comprenant de 1 à 30 atomes de carbone ou un groupe phényle ;
- 25 - $\text{CO}(\text{NHOH})$;
- $\text{M}(\text{OR}^4)_{n-x}\text{Z}_x$ avec x étant un entier allant de 1 à $(n-1)$, M étant un métal ou un métalloïde, n étant un degré d'oxydation de M , R^4 représentant un atome d'hydrogène, un groupe alkyle comprenant de 1 à 30 atomes de carbone, un groupe phényle, un cation métallique monovalent, ou un groupe de formule N^+R^1_4 , avec R^1 représentant un atome d'hydrogène, un groupe alkyle comprenant de 1 à 30 atomes de carbone, ou un groupe
- 30

- phényle, et Z représente un atome d'hydrogène, un groupe alkyle comprenant de 1 à 30 atomes de carbone, un groupe phényle ou un atome d'halogène ;
- $\text{SO}_3\text{M}'$ avec M' représentant un atome d'hydrogène, un cation métallique monovalent ou un groupe de formule N^+R^1_4 avec R^1 représentant un atome d'hydrogène, un groupe alkyle comprenant de 1 à 30 atomes de carbone ou un groupe phényle ;
 - $\text{B}(\text{OM}')_2$ avec M' représentant un atome d'hydrogène, un cation métallique monovalent ou un groupe de formule N^+R^1_4 avec R^1 représentant un atome d'hydrogène, un groupe alkyle comprenant de 1 à 30 atomes de carbone ou un groupe phényle ;
 - OH ;
- et les combinaisons de ceux-ci.

Pour le groupe de formule $-\text{M}(\text{OR}^4)_{n-x}\text{Z}_x$ telle que définie précédemment, M peut représenter un élément métallique, tel qu'un élément de transition de degré d'oxydation n donné ou un élément métalloïde tel que Al, Ga, In, Si de degré d'oxydation n donné, les degrés d'oxydation envisageables pour chaque élément métallique ou métalloïde étant connu de l'homme du métier. A titre d'exemple de groupe conforme à cette définition, on peut citer le groupe de formule $-\text{Si}(\text{OR}^4)_{3-x}\text{Z}_x$ avec x étant un entier allant de 1 à 3.

Le greffage chimique avec le substrat en céramique oxyde poreuse se fait avantageusement par les groupes énumérés précédemment. On précise que le ou les groupes aptes à se polymériser et les groupes susmentionnés peuvent être liés directement par le biais d'une liaison simple covalente ou par le biais d'un groupe alkylène comprenant de 1 à 30 atomes de carbone ou un groupe phényle.

Les groupes listés ci-dessus formant pont entre le substrat en céramique et le groupe apte à se polymériser sont particulièrement avantageux dans le cadre de cette invention, car ces groupes sont globalement non conducteurs de l'électricité.

Le ou les groupes susceptibles d'être polymérisés avec un ou plusieurs précurseurs d'un polymère conducteur de l'électricité peuvent être choisis avantageusement parmi les groupes acétylène, p-phénylène, p-phénylènevinylène, p-phénylènesulfure, pyrrole, thiophène, furane, azulène, azine, aniline, cyanophénylène vinylène, p-pyridyl vinylène.

Comme cela a été mentionné précédemment, le substrat est en céramique oxyde poreuse semi-conductrice. Il est entendu que, selon que le ou les polymères conducteurs de l'électricité sont des polymères de type N ou P, la céramique oxyde sera choisie de manière à être de type P ou N, ce choix étant à la portée de l'homme du métier. Les céramiques oxydes peuvent être des céramiques à base de métaux de transition choisis parmi Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Y, Zr, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt ou à base de lanthanides, tels que La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Er, et Yb ou à base d'éléments du groupe IIIA de la classification périodique choisis parmi Al, Ga, In et Tl ou à base d'éléments du groupe IVA de la classification périodique choisis parmi Si, Ge, Sn et Pb ou à base d'éléments du groupe VIA de la classification périodique choisis parmi Se et Te. Les céramiques oxydes peuvent être aussi toutes combinaisons entre métaux de transition, entre lanthanides, entre éléments du groupe IIIA, entre éléments du groupe IVA et éléments du groupe VIA.

Au sens de la présente invention, on entend par « céramique oxyde poreuse » une céramique métallique présentant des atomes d'oxygène et présentant une porosité globalement ouverte. Des
5 céramiques appropriées peuvent être des céramiques oxydes amorphes, nanocristallines et/ou mésoporeuses.

Par céramique oxyde amorphe, on entend une céramique ne présentant pas de cristallites ou des cristallites de taille sub-nanométriques.

10 Par céramique oxyde nanocristalline, on entend une céramique présentant des cristallites de l'ordre de quelques nanomètres, par exemple de 2 à 200 nm.

Enfin, par céramique oxyde mésoporeuse, on
15 entend une céramique se caractérisant par une importante porosité, avec des tailles de pores allant de 2 à 80 nm et des parois de 5 à 30 nanomètres d'épaisseur. Les pores sont généralement répartis de manière aléatoire avec une distribution très large de
20 la taille des pores, dans la gamme mentionnée ci-dessus. Les céramiques mésoporeuses utilisées selon l'invention sont avantageusement des céramiques « mésostructurées », qui se présentent sous forme de réseaux poreux organisés qui présentent un agencement
25 spatial ordonné de mésopores. Cette périodicité spatiale des pores est caractérisée par l'apparition d'au moins un pic à bas angle dans un diagramme de diffusion des rayons X ; ce pic est associé à une distance de répétition qui est généralement comprise
30 entre 2 et 50 nm. Les matériaux mésostructurés se caractérisent par une maximisation de la surface par un volume donné et l'assurance de la continuité du réseau solide selon au moins une direction de l'espace au travers des parois constituant ledit matériau.

Un exemple de céramique oxyde poreuse pouvant être utilisée selon l'invention est du dioxyde de titane TiO_2 .

5 Parmi les céramiques envisagées dans le paragraphe précédent, l'homme de l'art peut choisir des céramiques de type N (auquel cas le polymère conducteur greffé sera un polymère de type P) et ou des céramiques de type P (auquel cas le polymère conducteur greffé
10 sera un polymère de type N)

Selon l'invention, la surface ainsi que l'intérieur du substrat en céramique poreuse est greffé, à l'issue du procédé, par un ou plusieurs polymères conducteurs de l'électricité.

15 Des polymères adéquats peuvent être choisis parmi le groupe constitué par le polyacétylène, le poly(p-phénylène), le poly(p-phénylènevinylène), le poly(p-phénylènesulfure), le polypyrrole, le polythiophène, le polyfurane, le polyazulène, le
20 polyazine, la polyaniline le polycyanophénylène vinylène, le poly(para pyridyl vinylène) ainsi que toute forme de mélanges de ceux-ci.

Parmi cette liste de polymères, les polymères de type N sont le polycyanophénylène vinylène
25 et le poly(p-pyridyl vinylène).

Parmi cette liste de polymères, les polymères de type P sont le poly(p-phénylène), le poly(p-phénylènevinylène), le poly(p-phénylènesulfure), le polypyrrole, le polythiophène, le polyfurane, le
30 polyazulène, le polyazine et la polyaniline.

Enfin, ledit matériau peut comprendre en outre une ou plusieurs substances chromophores sensibilisant ladite céramique. On précise que, selon
35 la nature de la substance chromophore, celle-ci peut

être soit adsorbée soit greffée chimiquement à la surface et à l'intérieur du substrat en céramique oxyde.

On précise que, selon l'invention, on
5 entend par substance chromophore une substance apte à absorber une lumière dans le domaine IR, UV et visible et à libérer en contrepartie de cette absorption des électrons. Dans le cadre de l'invention, les électrons
10 vont être captés soit par la céramique oxyde (si celle-ci est semi-conductrice N) soit par le ou les polymères conducteurs de l'électricité (si ceux-ci sont des polymères de type N), tandis que les trous de charges laissés par les électrons libérés sont captés soit par
15 la céramique oxyde (si celle-ci est semi-conductrice de type P) soit par le ou les polymères conducteurs de l'électricité (si ceux-ci sont des polymères de type P).

Il est entendu qu'une substance chromophore
20 donnée présente une sensibilité spectrale bien déterminée et que le choix de cette substance devra être adaptée à la source de lumière, afin de présenter un rendement d'absorption de lumière aussi performant que possible.

25

L'invention a également trait, selon un second objet, à un procédé de préparation d'un matériau semi-conducteur tel que défini précédemment comprenant successivement les étapes suivantes :

30 - une étape de fonctionnalisation d'un substrat en céramique oxyde poreuse (sensibilisée ou non par une ou plusieurs substances chromophores) par greffage chimique d'un ou plusieurs composés comprenant au moins un groupe susceptible d'être polymérisé avec
35 un ou plusieurs précurseurs d'un polymère conducteur de

l'électricité et au moins un groupe apte à se greffer chimiquement audit substrat ;

- une étape d'imprégnation dudit substrat ainsi fonctionnalisé par une solution comprenant le ou lesdits précurseur(s) ;
- une étape de polymérisation du ou desdits précurseurs.

Ainsi, le procédé de l'invention permet, grâce à l'étape de fonctionnalisation de la céramique oxyde poreuse par un ou des composés mentionnés ci-dessus, d'améliorer la jonction entre la surface du substrat en céramique oxyde et le ou les polymères résultant de l'étape de polymérisation du ou desdits précurseurs mentionnés ci-dessus.

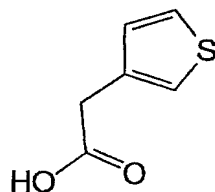
Le procédé de l'invention met en œuvre, comme certains procédés de l'art antérieur, une étape d'imprégnation d'un substrat en céramique oxyde poreuse, mais, contrairement à l'art antérieur, l'imprégnation selon l'invention se fait avec des précurseurs de polymère et non des polymères en soi, ce qui permet une amélioration de l'interpénétration dans la céramique poreuse des espèces s'infiltrant en raison de la taille des précurseurs inférieures à la taille des polymères utilisés dans l'art antérieur.

Grâce aux deux étapes susmentionnées, le procédé de l'invention permet à la fois une meilleure jonction entre la surface du substrat en céramique oxyde et le ou les polymères et une meilleure interpénétration de ceux-ci dans la céramique poreuse et donc une meilleure interpénétration des zones N et P susmentionnées.

Comme mentionné précédemment, le procédé selon l'invention comprend, en premier lieu, une étape de fonctionnalisation de la surface d'un substrat en céramique oxyde poreuse par un ou plusieurs composés tels que définis précédemment.

Au sens de la présente invention, on entend par « céramique oxyde poreuse » une céramique telle que définie précédemment. Le ou les composés comprenant un groupe apte à être polymérisé avec un ou plusieurs précurseurs d'un polymère conducteur de l'électricité, sont des composés aptes à se greffer chimiquement à la surface de la céramique oxyde susmentionnée. Ils sont tels que définis précédemment.

Un composé particulièrement avantageux est le composé répondant à la formule suivante :



Des groupes susceptibles de se polymériser peuvent être par exemple, des groupes acétylène, p-phénylène, p-phénylènevinylène, p-phénylènesulfure, pyrrole, thiophène, furane, azulène, azine, aniline, cyanophénylène vinylène, p-pyridyl vinylène. Pour ces groupes, les précurseurs aptes à polymériser avec eux seront respectivement les monomères acétylène, p-phénylène, p-phénylènevinylène, p-phénylènesulfure, pyrrole, thiophène, furane, azulène, azine, aniline, cyanophénylène vinylène, p-pyridyl vinylène, qui donneront, après polymérisation respectivement les polymères suivants : le polyacétylène, le poly(p-phénylène), le poly(p-phénylènevinylène), le poly(p-phénylènesulfure), le polypyrrole, le polythiophène, le

polyfurane, le polyazulène, le polyazine, la polyaniline le polycyanophénylène vinylène, le poly(p-pyridyl vinylène).

Les groupes aptes à se greffer chimiquement à la surface d'une céramique oxyde et les groupes susceptibles de se polymériser lors d'une réaction d'une polymérisation peuvent être soit liés directement (c'est-à-dire par une liaison simple) soit séparés par un groupe espaceur, qui peut être un groupe alkylène comportant de 1 à 30 atomes de carbone ou un groupe phénylène. La présence d'un tel groupe espaceur peut permettre de régler la distance vis-à-vis d'une ou plusieurs substances chromophores, si celles-ci sont présentes.

Comme il est précisé plus haut, une surface en céramique est fonctionnalisée par des composés tel que définis précédemment, lesdits composés se greffant chimiquement à ladite surface.

Pour obtenir une telle fonctionnalisation, différentes techniques peuvent être envisagées, en particulier des techniques par voie liquide, c'est-à-dire par imprégnation du substrat sus-mentionné avec une solution comprenant le ou les composés tels que définis ci-dessus.

Ainsi, la fonctionnalisation par greffage chimique de la surface et de l'intérieur de la céramique oxyde poreuse peut s'effectuer par l'une des techniques suivantes :

- le trempage-retrait (connu sous la terminologie anglaise « dip-coating ») ;
- l'enduction centrifuge (connu sous la terminologie anglaise « spin-coating ») ;

- l'enduction laminaire (connu sous la terminologie anglaise « laminar-flow-coating ») ;
- la pulvérisation (connu sous la terminologie anglaise « spray-coating »)
- 5 - l'épandage (connu sous la terminologie anglaise « soak coating ») ;
- l'enduction au rouleau (connu sous la terminologie « roll to roll process ») ;
- l'enduction au pinceau (connu sous la terminologie anglaise « painting coating ») ;
- 10 - la sérigraphie (connu sous la terminologie anglaise « screen printing »).

Ces différentes techniques doivent être mises en œuvre pendant un temps approprié, de manière à
15 permettre un contact optimum du substrat en céramique oxyde poreuse avec la solution comprenant le ou les composés aptes à être greffés, de façon à ce que le substrat soit imprégné à la fois à sa surface et en son intérieur et à ce que les composés puissent réagir et
20 se lier chimiquement à la surface et à l'intérieur dudit substrat.

On précise que la solution peut comprendre également une ou plusieurs substances chromophores, auquel cas l'étape de fonctionnalisation s'accompagnera
25 d'une sensibilisation du substrat en céramique oxyde par la ou lesdites substances chromophores.

Le procédé de l'invention peut comprendre également en alternative une étape d'imprégnation dudit substrat, avant l'étape de fonctionnalisation ou après
30 celle-ci, par une solution comprenant une ou plusieurs substances chromophores de manière à sensibiliser ledit substrat.

La ou les substances chromophores envisageables sont les mêmes que celles mentionnées ci-
35 dessus.

Après cette étape de fonctionnalisation, le procédé de l'invention peut comprendre une étape de traitement destiné à éliminer les résidus de la réaction de greffage ainsi que les espèces n'ayant pas réagi.

On précise que le greffage ou l'adsorption de substances chromophores, le cas échéant, pourra se faire par les mêmes voies que la fonctionnalisation par des composés tels que définis précédemment, voire même simultanément à celle-ci.

Une fois l'étape de fonctionnalisation achevée, le procédé de l'invention prévoit une étape d'imprégnation du substrat ainsi fonctionnalisé par un ou plusieurs précurseurs tels que définis précédemment.

Concrètement, cette étape consiste à imprégner le substrat ainsi fonctionnalisé par une solution organique comprenant le ou lesdits précurseurs.

L'imprégnation par un ou plusieurs précurseurs de polymères conducteurs de l'électricité se fait par voie liquide, plus précisément par une des techniques mentionnées ci-dessus :

- le trempage-retrait (connu sous la terminologie anglaise « dip-coating ») ;
- l'enduction centrifuge (connu sous la terminologie anglaise « spin-coating ») ;
- l'enduction laminaire (connu sous la terminologie anglaise « laminar-flow-coating ») ;
- la pulvérisation (connu sous la terminologie anglaise « spray-coating »)
- l'épandage (connu sous la terminologie anglaise « soak coating ») ;
- l'enduction au rouleau (connu sous la terminologie « roll to roll process ») ;

- l'enduction au pinceau (connu sous la terminologie anglaise « painting coating »)
- la sérigraphie (connu sous la terminologie anglaise « screen printing »).

5 Ces techniques doivent être mises en œuvre pendant un temps adéquat de manière à imprégner à la fois la surface du substrat en céramique oxyde et les pores de celles-ci.

10 Une fois l'étape d'imprégnation achevée, il est alors possible de démarrer l'étape de polymérisation. Cette étape consiste à faire croître par polymérisation des précurseurs des chaînes polymères à partir des groupes susceptibles d'être polymérisés avec le ou lesdits précurseurs.

15 Cette étape de polymérisation peut démarrer par ajout dans la solution susmentionnée d'un amorceur de polymérisation, lorsque la polymérisation envisagée est une polymérisation chimique.

20 Par amorceur de polymérisation, on entend un réactif apte à déclencher la réaction de polymérisation entre les composés adsorbés et le ou les précurseurs susmentionnés. Concrètement, cet amorceur va créer des centres réactifs, à l'origine de la propagation de la réaction de polymérisation. Le choix
25 de l'amorceur sera aisément réalisé par l'homme de l'art en fonction du polymère à synthétiser. En particulier, cet amorceur pourra être un oxydant (exemple : le trichlorure de fer FeCl_3) pour polymériser par oxydation chimique des composés de la
30 famille des polythiophènes.

Il est également possible d'envisager, selon l'invention, une polymérisation électrochimique des précurseurs de l'invention. Dans ce cas, l'on fait passer un courant à travers le substrat imprégné de la
35 solution comprenant le ou lesdits précurseurs, ledit

courant déclenchant la polymérisation du ou desdits précurseurs.

Des précurseurs susceptibles de se polymériser par polymérisation électrochimique sont par exemple, le thiophène, le pyrrole et leurs analogues.

Une fois l'étape de polymérisation achevée, le procédé de l'invention peut comprendre une étape de traitement destiné à éliminer le ou les solvants présents dans la solution d'imprégnation, les résidus de réaction et les précurseurs n'ayant pas réagi.

Le procédé selon l'invention présente de nombreux avantages. En effet :

- il permet une bonne interpénétration entre la zone constituée de la céramique oxyde poreuse et les polymères conducteurs électriques greffés à la surface de cette zone ;
- il met en œuvre des techniques simples, réalisables à température ambiante.

Les matériaux semi-conducteurs de l'invention peuvent être utilisés dans différents dispositifs nécessitant la présence d'un matériau semi-conducteur tels que des dispositifs électrochimiques, des dispositifs photo-électrochimiques et des dispositifs de catalyse et en particulier dans des cellules photovoltaïques ou les diodes électroluminescentes.

Ainsi, la présente invention a également pour objet une cellule photovoltaïque comprenant :

- une première électrode collectrice de courant (dite « électrode de travail ») ;
- une seconde électrode (dite « contre-électrode de travail ») ;

- une zone semi-conductrice constituée du matériau semi-conducteur tel que défini précédemment, ladite zone étant disposée entre ladite première électrode et ladite seconde électrode.

5 La première électrode, ou électrode de travail comprend une partie conductrice sous forme, par exemple, d'une couche d'oxyde d'étain dopé au fluor, cette partie pouvant être déposée sur un support.

10 On précise que par support, on entend, au sens de l'invention, tout substrat, organique ou inorganique, se caractérisant par une transparence au moins égale à 50% dans le spectre solaire. Ce support peut être par exemple en verre transparent.

15 Il est noté que la partie conductrice susmentionnée sera en contact avec la zone semi-conductrice susmentionnée, soit de manière directe, soit par le biais d'une couche de dioxyde de titane dense, cette dernière permettant d'éviter un contact direct entre l'électrode de travail et la zone semi-conductrice et de ce fait un court-circuit dans la
20 cellule photovoltaïque.

 Il est précisé également qu'une couche à base de polymère conducteur de l'électricité peut être interposée entre ladite zone semi-conductrice et la
25 seconde électrode (dite « contre-électrode de travail »), de manière à éviter un court-circuit dans la cellule photovoltaïque.

 Généralement, la seconde électrode (ou « contre-électrode de travail ») se présente sous la
30 forme d'une couche métallique, par exemple une couche métallique à base d'or et/ou de nickel.

 Les cellules photovoltaïques conçues à partir du matériau hybride inorganique-organique semi-conducteur P-N de l'invention présentent les avantages
35 suivants :

- le fait de greffer des polymères conducteurs de l'électricité via des composés tels que définis précédemment sur et dans la céramique oxyde poreuse favorise le transfert des charges au moment de la dissociation électron-trou entre la céramique, les polymères conducteurs et éventuellement le ou les substances chromophores ;

- le fait d'utiliser un matériau semi-conducteur conforme à l'invention présentant une excellente interpénétration des zones N et des zones P confère une efficacité de ladite électrode photo-active dans toute son épaisseur et fournit ainsi une configuration favorable pour améliorer le rendement solaire des cellules photovoltaïques solides, éventuellement à colorant.

En se référant à la figure 1, on voit une cellule photovoltaïque conforme à la présente invention désignée par la référence générale 1.

La cellule 1 comprend un support 3 transparent en verre recouvert sur une face 5 par une couche conductrice transparente 7, cette couche pouvant être à base d'oxyde d'étain dopé au fluor. Le support revêtu de la couche conductrice transparente fait office d'électrode collectrice de courant (dite première électrode selon la terminologie employée ci-dessus).

Une couche dense de dioxyde de titane 9 est déposée sur la couche conductrice transparente 7. Sur cette couche dense est disposée une couche de matériau semi-conducteur 11, ledit matériau semi-conducteur correspondant au matériau hybride inorganique-organique semi-conducteur P-N de l'invention. Sur cette couche en matériau semi-conducteur 11 est déposée une couche en polymère conducteur 13, sur laquelle est déposée une couche métallique 15, par exemple une couche à base

d'or et de nickel. La couche en polymère conducteur 13, prise en sandwich entre la couche en matériau semi-conducteur 11 et la couche métallique 15, permet de limiter les phénomènes de court circuit. La couche
5 métallique 15 fait office de contre-électrode (dite seconde électrode selon la terminologie employée ci-dessus).

La figure 2 représente une partie agrandie de la couche en matériau semi-conducteur 11 et montre
10 plus précisément l'interface entre la surface du substrat en céramique oxyde poreuse et le polymère conducteur de l'électricité et une substance chromophore.

Sur cette figure, la référence 17 désigne
15 une surface de la paroi d'un pore de la céramique oxyde poreuse. Sur cette surface est greffée un polymère conducteur de l'électricité 19 via un composé 21 tel que défini précédemment comportant un groupe permettant le greffage chimique sur la surface de la paroi d'un
20 pore de la céramique oxyde poreuse 17. A proximité de ce polymère conducteur de l'électricité 19, la surface 17 est sensibilisée par une substance chromophore 23 (adsorbée ou greffée à ladite surface). Lorsqu'un rayon lumineux atteint la substance chromophore (ledit rayon
25 lumineux étant représentée par une flèche $h\nu$), l'énergie lumineuse qu'il transporte sous forme de photons est absorbée par la substance chromophore. Celle-ci se libère d'un électron e^- qui est directement, dans ce cas de figure, capté par la
30 céramique oxyde poreuse, tandis que le trou de charge symbolisé + créé de manière concomittante à l'électron est capté par le polymère conducteur. Il y a ainsi une dissociation de la paire électron-trou sans recombinaison et donc création d'un courant électrique
35 au sein de matériau.

Les cellules photovoltaïques de la présente invention peuvent être préparées de la façon suivante :

- 5 - une étape de dépôt sur un support recouvert éventuellement d'une couche conductrice transparente d'un film de céramique oxyde, ledit dépôt pouvant se faire par des techniques sous vide ou par voies humides précédemment décrites, ces deux types de procédés étant à la portée de l'homme du métier ;
- 10 - la mise en œuvre du procédé de préparation du matériau semi-conducteur tel que défini précédemment, de manière à obtenir à partir du film de céramique oxyde susmentionné ledit matériau semi-conducteur;
- 15 - éventuellement, une étape de dépôt sur la couche en matériau conducteur d'une couche en polymère conducteur de l'électricité, de préférence, identique à celui constitutif du matériau hybride inorganique-organique semi-conducteur P-N de l'invention, ladite
- 20 couche étant déposée par des techniques par voie humide précédemment décrites, à la portée de l'homme du métier ;
- 25 - une étape de dépôt d'une couche métallique telle que définie précédemment sur la couche en matériau semi-conducteur ou le cas échéant sur la couche en polymère conducteur de l'électricité.

La présente invention va maintenant être décrite par rapport à un exemple de réalisation.

30 BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS ET DES SPECTRES

La figure 1 correspond à une vue en coupe d'une cellule photovoltaïque de l'invention, déjà décrite.

La figure 2 correspond à une partie agrandie d'une partie de la cellule représentée sur la figure 1, cette partie étant décrite ci-dessus.

La figure 3 montre le spectre en transmission (représenté en noir) d'une cellule photovoltaïque sans contre-électrode, préparées selon le mode de réalisation proposé ci-après et, à titre d'exemple, le spectre d'émission du soleil (représenté en gris).

10

L'invention va maintenant être décrite en référence à l'exemple ci-dessous.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PARTICULIERS

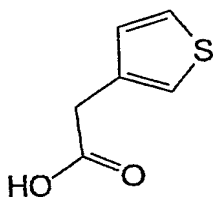
15 Exemple : Procédé d'élaboration d'un matériau hybride inorganique-organique semi-conducteur P-N pour la réalisation d'une cellule photovoltaïque.

20 Un substrat de verre de $2 \times 5 \text{ cm}^2$ recouvert d'une couche conductrice transparente à base de $\text{SnO}_2:\text{F}$ (fabriqué par la firme japonaise ASAHI Glass Corporation) de résistance de surface de l'ordre de 10 Ohm carré et partiellement recouvert d'une fine couche de TiO_2 dense déposée par pulvérisation à chaud est
25 tout d'abord nettoyé à l'aide d'un détergent, puis rincé abondamment à l'eau et séché à l'éthanol.

La couche de matériau hybride inorganique-organique semi-conducteur P-N de l'invention est tout d'abord préparée en déposant sur la couche de TiO_2
30 dense une couche poreuse de TiO_2 par sérigraphie (ou « screen printing ») à partir de la pâte commercialisée

sous le nom de Ti-Nanoxide HT par la société suisse Solaronix. L'ensemble est ensuite densifié à 450°C durant 15 minutes. La couche de la céramique oxyde poreuse de TiO_2 obtenue a une épaisseur de 3 μm . Elle
 5 constitue le matériau semi-conducteur de type N du matériau hybride inorganique-organique semi-conducteur P-N.

Le composé comportant un motif thiophène et un groupe carboxylique permettant le greffage chimique
 10 avec la surface de la paroi d'un pore de la céramique oxyde poreuse sélectionné est l'acide 3-thiophène acétique (commercialisé par Aldrich sous la référence 22,063-9) suivant :



15 On a choisit comme substance chromophore, le cis-bis(isothiocyanato)bis(2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylato)-ruthenium(II) bis-tétrabutylammonium commercialisé sous le nom de Ruthenium 535 bis-TBA par la société suisse Solaronix.

20 Le composé et la substance chromophore sont dissous en proportion équimolaire dans une solution à base d'éthanol.

La céramique oxyde poreuse de TiO_2 est ensuite immergée dans la solution contenant le composé
 25 et la substance chromophore durant 24 heures. Ainsi, le composé et la substance chromophore sont greffés à la surface de la paroi d'un pore de la céramique oxyde poreuse de TiO_2 grâce à leurs groupements

carboxyliques complexants. La céramique oxyde poreuse ainsi fonctionnalisée est ensuite rincée à l'éthanol. Après le greffage du composé et de la substance chromophore, le polymère conducteur d'électricité

5 constituant le matériau semi-conducteur P du matériau hybride inorganique-organique semi-conducteur P-N est élaboré de la manière suivante : la couche d'oxyde ainsi fonctionnalisée est immergée dans une solution 0,1 M d'alkylthiophène dans le chloroforme. Une

10 solution 0,3 M de chlorure de fer (FeCl_3) est alors introduite afin d'amorcer la polymérisation. Après 12H à température ambiante, le substrat est rincé au chloroforme puis à l'éthanol. Le substrat est finalement rincé soigneusement au chloroforme afin

15 d'extraire le polymère non greffé.

Une couche de polymère conducteur est ensuite déposée sur la couche de matériau hybride inorganique-organique semi-conducteur P-N par enduction centrifuge (connu sous la terminologie anglaise « spin-

20 coating ») à partir d'une solution de polyalkylthiophène à 5% en masse dans le chloroforme. La figure 3 montre le spectre en transmission de l'empilement ainsi préparé.

Une contre-électrode d'or est déposée sur

25 la couche de polymère conducteur par évaporation sous vide.

Sous éclairage de la cellule photovoltaïque ainsi réalisée, on observe un courant électrique entre l'électrode et la contre-électrode :

30 ceci montre que sous forme de couche, le matériau hybride inorganique-organique semi-conducteur P-N

permet d'absorber les photons constitutifs de la lumière, de donner naissance à un électron et un trou (on parle de paire électron-trou), de séparer ladite paire à la jonction P-N, de créer une différence de
5 potentiel à la jonction P-N et ainsi de générer un courant électrique entre l'électrode et la contre-électrode.

Références citées.

- [1] WO 93/19479 ;
- [2] EP 1 176 646 ;
- 5 [3] EP 0 917 208 ;
- [4] WO 93/20569.

REVENDECATIONS

1. Matériau semi-conducteur P-N susceptible d'être obtenu par un procédé comprenant successivement les étapes suivantes :

- 5 - une étape de fonctionnalisation d'un substrat en céramique oxyde poreuse par greffage chimique d'un ou plusieurs composés comprenant au moins un groupe susceptible d'être polymérisé avec un ou plusieurs précurseurs d'un polymère conducteur de l'électricité et au moins un groupe apte à se greffer chimiquement audit substrat ;
- une étape d'imprégnation dudit substrat ainsi fonctionnalisé par une solution comprenant le ou lesdits précurseur(s) ;
- 15 - une étape de polymérisation du ou desdits précurseurs.

2. Matériau semi-conducteur selon la revendication 1, dans lequel la céramique oxyde poreuse est choisie parmi des céramiques à base de métaux de transition choisis parmi Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Y, Zr, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt ou à base de lanthanides, tels que La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Er, et Yb ou à base d'éléments du groupe IIIA de la classification périodique choisis parmi Al, Ga, In et Tl ou à base d'éléments du groupe IVA de la classification périodique choisis parmi Si, Ge, Sn et Pb ou à base d'éléments du groupe VIA de la classification périodique choisis parmi Se et Te.

3. Matériau semi-conducteur selon la revendication 1 ou 2, dans lequel la céramique oxyde poreuse est une céramique mésoporeuse.

4. Matériau semi-conducteur selon la revendication 3, dans lequel la céramique mésoporeuse est mésostructurée.

5 5. Matériau semi-conducteur selon la revendication 1 ou 4, dans lequel la céramique est du dioxyde de titane TiO_2 .

10 6. Matériau semi-conducteur selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans lequel le ou les groupes aptes à se greffer chimiquement à la céramique sont choisis parmi les groupes de formules suivantes :

15 - COOR^1 avec R^1 représentant un atome d'hydrogène, un groupe alkyle comprenant de 1 à 30 atomes de carbone ou un groupe phényle ;

- COCl ;

20 - $\text{COCH}_2\text{CO}-\text{R}^1$ avec R^1 représentant un atome d'hydrogène, un groupe alkyle comprenant de 1 à 30 atomes de carbone ou un groupe phényle ;

- $\text{PO}(\text{OH})_2$, $-\text{PO}(\text{OR}^2)(\text{OH})$ ou $-\text{PO}(\text{OR}^2)(\text{OR}^3)$ avec R^2 et R^3 , identiques ou différents, représentant un groupe alkyle comprenant de 1 à 30 atomes de carbone ou un groupe phényle ;

25 - $\text{CO}(\text{NHOH})$;

30 - $\text{M}(\text{OR}^4)_{n-x}\text{Z}_x$ avec x étant un entier allant de 1 à $(n-1)$, M étant un métal ou un métalloïde, n étant un degré d'oxydation de M , R^4 représentant un atome d'hydrogène, un groupe alkyle comprenant de 1 à 30 atomes de carbone, un groupe phényle, un cation métallique monovalent, ou un groupe de formule N^+R^1_4 , avec R^1 représentant un atome d'hydrogène, un groupe alkyle comprenant de 1 à 30 atomes de carbone, ou un groupe phényle, et Z représente un atome d'hydrogène, un

groupe alkyle comprenant de 1 à 30 atomes de carbone, un groupe phényle ou un atome d'halogène;

- $\text{SO}_3\text{M}'$ avec M' représentant un atome d'hydrogène, un cation métallique monovalent ou un groupe de formule N^+R^1_4 avec R^1 représentant un atome d'hydrogène, un groupe alkyle comprenant de 1 à 30 atomes de carbone ou un groupe phényle ;

- $\text{B}(\text{OM}')_2$ avec M' représentant un atome d'hydrogène, un cation métallique monovalent ou un groupe de formule N^+R^1_4 avec R^1 représentant un atome d'hydrogène, un groupe alkyle comprenant de 1 à 30 atomes de carbone ou un groupe phényle ;

- OH ;

et les combinaisons de ceux-ci.

15

7. Matériau semi-conducteur selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le ou les groupes susceptibles d'être polymérisés avec un ou plusieurs précurseurs d'un polymère conducteur de l'électricité sont choisis parmi les groupes acétylène, p-phénylène, p-phénylènevinylène, p-phénylènesulfure, pyrrole, thiophène, furane, azulène, azine, aniline, cyanophénylène vinylène, p-pyridyl vinylène.

25

8. Matériau semi-conducteur selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, comprenant, en outre, une ou plusieurs substances chromophores sensibilisant ladite céramique.

30

9. Procédé de préparation d'un matériau semi-conducteur tel que défini selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, comprenant successivement les étapes suivantes :

- une étape de fonctionnalisation d'un substrat en céramique oxyde poreuse par greffage

chimique d'un ou plusieurs composés comprenant au moins un groupe susceptible d'être polymérisé avec un ou plusieurs précurseurs d'un polymère conducteur de l'électricité et au moins un groupe apte à se greffer chimiquement audit substrat ;

- une étape d'imprégnation dudit substrat ainsi fonctionnalisé par une solution comprenant le ou lesdits précurseur(s) ;

- une étape de polymérisation du ou desdits précurseurs.

10. Cellule photovoltaïque comprenant :

- une première électrode collectrice de courant (dite « électrode de travail ») ;

- une seconde électrode (dite « contre-électrode de travail ») ;

- une zone semi-conductrice constituée d'un matériau tel que défini selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, ladite zone étant disposée entre ladite première électrode et ladite seconde électrode.

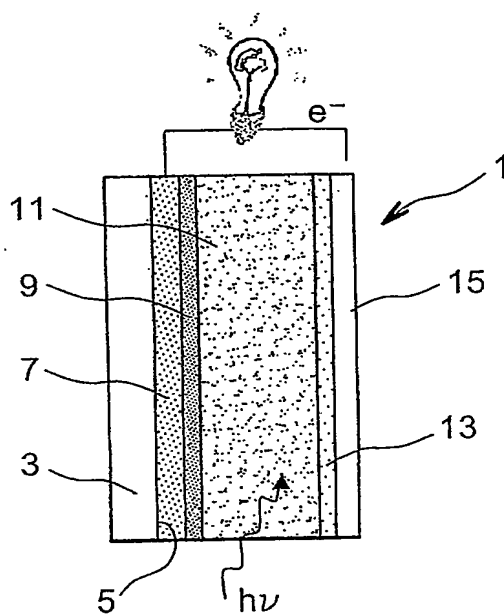


FIG. 1

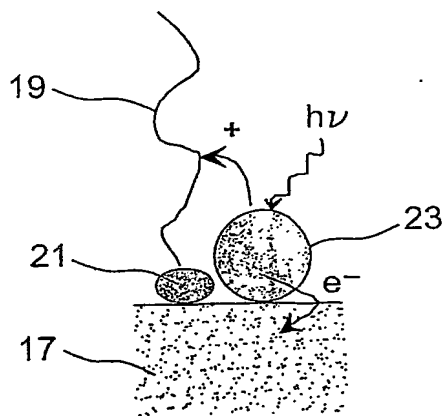


FIG. 2

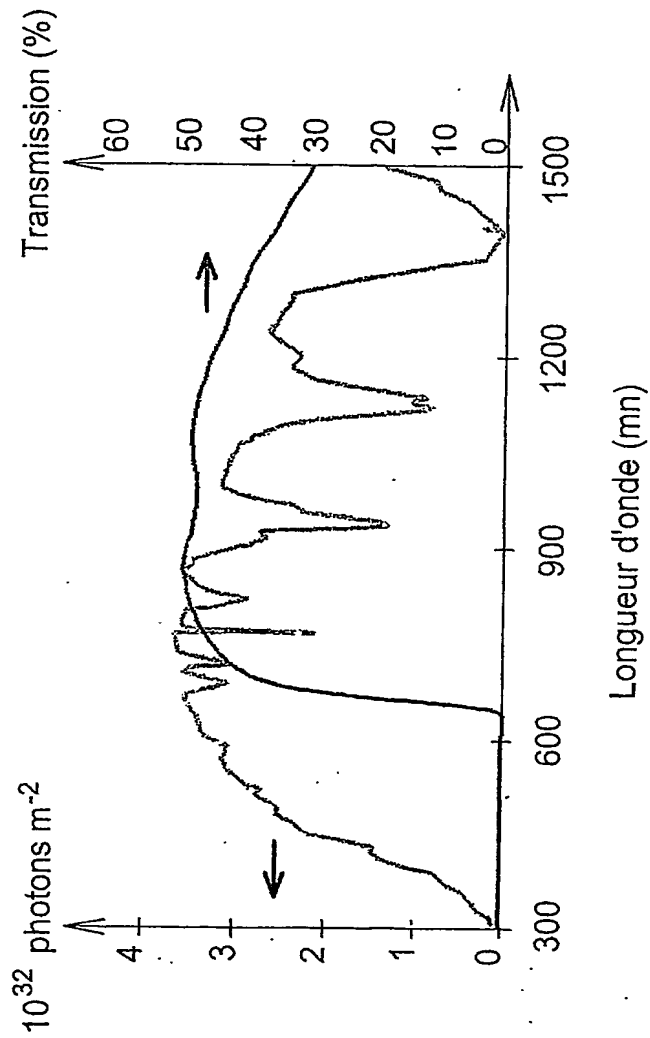


FIG. 3

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1../2..

INV

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 G W / 270601

Vos références pour ce dossier (facultatif)		B14319.3/FG YD184
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		03.50841 DU 17.11.2003
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)		
MATERIAU HYBRIDE INORGANIQUE-ORGANIQUE SEMI-CONDUCTEUR P-N, SON PROCEDE DE FABRICATION ET CELLULE PHOTOVOLTAÏQUE COMPRENANT LEDIT MATERIAU		
LE(S) DEMANDEUR(S) :		
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 31-33 rue de la Fédération 75752 PARIS 15 ème.		
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :		
1	Nom	BELLEVILLE
	Prénoms	Philippe
Adresse	Rue	25 rue Charles Gille
	Code postal et ville	37000 TOURS
Société d'appartenance (facultatif)		
2	Nom	SANCHEZ
	Prénoms	Clément
Adresse	Rue	9 Résidence du Château de Courcelles
	Code postal et ville	91190 GIF SUR YVETTE
Société d'appartenance (facultatif)		
3	Nom	BUVAT
	Prénoms	Pierrick
Adresse	Rue	1 rue Hector Berlioz
	Code postal et ville	37250 MONTBAZON
Société d'appartenance (facultatif)		
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.		
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		
PARIS LE 27 NOVEMBRE 2003 J. LEHU		

reçue le 26/11/03



BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235*03

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 2../2..

(À fournir dans le cas où les demandeurs et
les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 © W / 270601

Vos références pour ce dossier (facultatif)		B14319.3/FG YD184
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		03.50841 DU 17.11.2003
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) MATERIAU HYBRIDE INORGANIQUE-ORGANIQUE SEMI-CONDUCTEUR P-N, SON PROCEDE DE FABRICATION ET CELLULE PHOTOVOLTAÏQUE COMPRENANT LEDIT MATERIAU		
LE(S) DEMANDEUR(S) : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 31-33 rue de la Fédération 75752 PARIS 15 ème.		
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :		
1	Nom	PRENE
	Prénoms	Philippe
Adresse	Rue	2 rue Robert Vivier
	Code postal et ville	37200 TOURS
Société d'appartenance (facultatif)		
2	Nom	
	Prénoms	
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		
3	Nom	
	Prénoms	
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.		
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) PARIS LE 27 NOVEMBRE 2003 J. LEHU		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

PCT/FR2004/050591



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☒ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.